

КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819ВМ, КТ819ВМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $\tau_n \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$

КТ819А, КТ819АМ не более	25 В
КТ819Б, КТ819БМ, КТ819В	40–60*–80* В
КТ819В, КТ819ВМ, КТ819Г	60–80*–100* В
КТ819Г, КТ819ГМ, КТ819А	80–100*–110* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более

при $I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А

КТ819А, КТ819АМ, КТ819Б, КТ819БМ, КТ819В, КТ819ВМ, КТ819Г, КТ819ГМ, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	1 В
при $I_K = 20$ А, $I_B = 4$ А	2 В
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819ВМ, КТ819ГМ	5* В
при $I_K = 15$ А, $I_B = 3$ А	4* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А не более

КТ819А, КТ819АМ, КТ819Б, КТ819БМ, КТ819В, КТ819ВМ, КТ819Г, КТ819ГМ, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	1,5 В
КТ819А, КТ819АМ, КТ819Б, КТ819БМ, КТ819В, КТ819ВМ, КТ819Г, КТ819ГМ	3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_K = 5$ А не менее

при $T = 298$ К и $T = T_K$ макс

КТ819А, КТ819Б, КТ819В	20
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ	15
КТ819Б, КТ819БМ	20
КТ819Г, КТ819ГМ	12
при $T = 213$ К	9
при $T = 233$ К	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ	10
КТ819Б, КТ819БМ	15
КТ819Г, КТ819ГМ	7

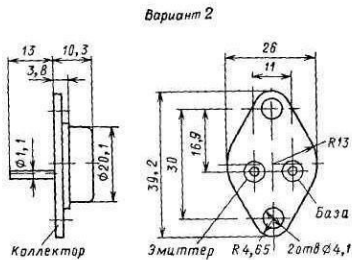
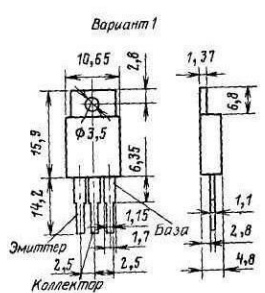
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_B = 0,5$ А

КТ819А, КТ819Б, КТ819В	3–5 МГц
КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	12 МГц

Транзисторы кремниевые меза-диффузионно-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные мощные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных схемах.

Транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (вариант 1), транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ — в металлоглазном корпусе с жесткими выводами (вариант 2). Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзисторов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г не более 2,5 г, транзисторов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ не более 20 г.



Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	25 В
КТ819А	40 В
КТ819Б	60 В
КТ819В	60 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом, $T = T_{мин} - 323$ К	
КТ819А, КТ819АМ	40 В
КТ819Б, КТ819БМ	50 В
КТ819В, КТ819ВМ	70 В
КТ819Г, КТ819ГМ	100 В
КТ819Б	80 В
КТ819В	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	10 А
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	15 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мс, $Q \geq 100$	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	15 А
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	20 А
Постоянный ток базы	3 А
Импульсный ток базы при $\tau_n \leq 10$ мс, $Q \geq 100$	5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_K \leq 298$ К	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	60 Вт
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	100 Вт
без теплоотвода при $T \leq 298$ К	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	1,5 Вт
КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	2 Вт
КТ819А, КТ819Б, КТ819В	3 Вт
Температура перехода	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В	423 К
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	398 К
Температура окружающей среды	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В	От 213 до $T_K = 398$ К
КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	От 233 до $T_K = 373$ К

Время выключения* при $I_K = 5$ А, $I_B = 0,5$ А не более

КТ819А, КТ819Б, КТ819В	2,5 мкс
Емкость коллекторного перехода* при $U_{КБ} = 5$ В	360–600–1000 пФ

Пробивное напряжение коллектор-база при $T = 213 - 298$ К, $I_K = 1$ мА и при $T = 398$ К, $I_K = 5$ мА не менее

КТ819А	100 В
КТ819Б	80 В
КТ819В	60 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 40$ В не более

КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	1 мА
при $T = 233 - 298$ К	
при $T = 373$ К	10 мА

Пробивное напряжение эмиттер-база при $I_B = 5$ мА не менее

КТ819А, КТ819Б, КТ819В	5 В
------------------------	-----

Примечания: 1. Постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода при $T_K = 298 - 373$ К снижается линейно на 0,015 Вт через 1 К КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г и на 0,02 Вт через 1 К КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ.

2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.

При монтаже в схему транзисторов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г допускается одноразовый изгиб выводов на расстоянии не менее 2,5 мм от корпуса под углом 90°, радиусом не менее 0,8 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

